



19 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

12 **Offenlegungsschrift**
10 **DE 100 43 204 A 1**

51 Int. Cl.7:
H 01 L 51/20
H 01 L 51/40
H 01 L 51/10

21 Aktenzeichen: 100 43 204.2
22 Anmeldetag: 1. 9. 2000
43 Offenlegungstag: 4. 4. 2002

DE 100 43 204 A 1

71 Anmelder:
Siemens AG, 80333 München, DE

72 Erfinder:
Bernds, Adolf, 91083 Baiersdorf, DE; Clemens,
Wolfgang, Dr., 90617 Puschendorf, DE; Fix, Walter,
Dr., 90762 Fürth, DE; Rost, Henning, Dr., 91056
Erlangen, DE

56 Entgegenhaltungen:

DE 198 51 703 A1
WO 99 10 939 A2
WO 97 18 944 A2

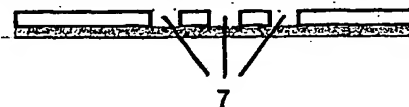
DRURY, C.J. et al.: "Low-cost al polymer inte-
grated circuits" in "Applied Physics Letters",
73 (1998) 1, pp. 108-110;
LIDZEY, D.G. et al.: "Photoprocessed and micro-
patterned conjugated polymer LEDs" in "Synthetic
Metals" 82 (1996), pp. 141-148;
XIANG-YANG, Zheng et al.: "Electrochemical
Patterning of the Surface of Insulators with
Electrically Conductive Polymers" in "J.Electro-
chem.Soc.", 142 (1995) 12, pp. L226f.;
KOBEL, W. et al.: "Generation of micropatterns
in Poly(3-Methyl-Thiophene) films using micro-
lithography: a first step in the design of an
all-organic thin-film transistor" in "Synthetic
Metals", 22 (1998), pp. 265-271;
ANGELAPOULUS, M. and SHAW, J.M.: "In-Situ
Radiation Induced Doping" in "Mol.Cryst.Lig-
Cryst.", 189 (1990), pp. 221-225;

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

54 Organischer Feld-Effekt-Transistor, Verfahren zur Strukturierung eines OFETs und integrierte Schaltung

57 Die Erfindung betrifft einen organischen Feld-Effekt-
Transistor, ein Verfahren zur Strukturierung eines OFETs
und eine integrierte Schaltung mit verbesserter Struktu-
rierung der Funktionspolymerschichten. Die Strukturie-
rung wird durch Einraken des Funktionspolymers in eine
Formschicht, in der zunächst durch Belichten Vertiefun-
gen erzeugt wurden, erzielt.



DE 100 43 204 A 1

BEST AVAILABLE COPY